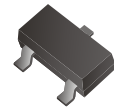


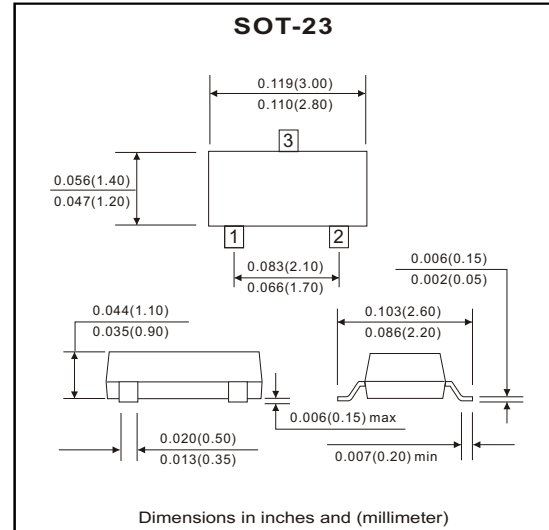
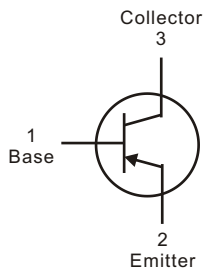
MMBT4403-G (PNP) RoHS Device



Features

-Switching transistor.

Marking: 2T



Maximum Ratings (at Ta=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-Base voltage	V _{CBO}	-40	V
Collector-Emitter voltage	V _{CEO}	-40	V
Emitter-Base voltage	V _{EBO}	-5	V
Collector current-continuous	I _C	-0.6	A
Collector power dissipation	P _C	300	mW
Junction temperature	T _J	150	°C
Storage temperature range	T _{STG}	-55 to +150	°C

Electrical Characteristics (at Ta=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typ.	Max	Unit
Collector-Base breakdown voltage	V _{(BR)CBO}	I _C =-100μA, I _E =0	-40			V
Collector-Emitter breakdown voltage	V _{(BR)CEO}	I _C =-1mA, I _B =0	-40			V
Emitter-Base breakdown voltage	V _{(BR)EBO}	I _E =-100μA, I _C =0	-5			V
Collector cut-off current	I _{CBO}	V _{CB} =-35V, I _E =0			-0.1	μA
Collector cut-off current	I _{CEO}	V _{CE} =-35V, I _B =0			-0.1	μA
Emitter cut-off current	I _{EBO}	V _{EB} =-4V, I _C =0			-0.1	μA
DC current gain	h _{FE}	V _{CE} =-2V, I _C =-150mA	100		300	
Collector-Emitter saturation voltage	V _{CE(SAT)}	I _C =-150mA, I _B =-15mA			-0.4	V
Base-Emitter saturation voltage	V _{BE(SAT)}	I _C =-150mA, I _B =-15mA			-0.95	V
Transition frequency	f _T	V _{CE} =-10V, I _C =-20mA f=100MHz	200			MHz

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (MMBT4403-G)

Fig. 1 Max. Power Dissipation vs. Ambient Temperature

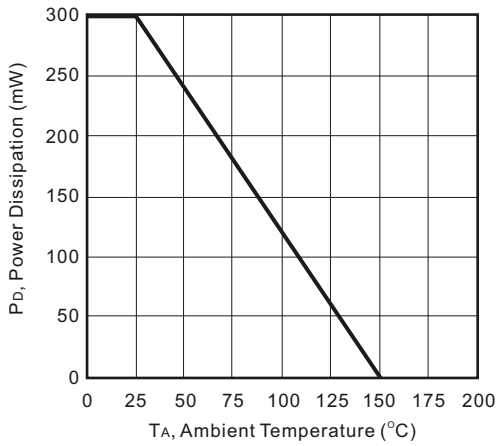


Fig. 2 Typical DC Current Gain vs. Collector Current

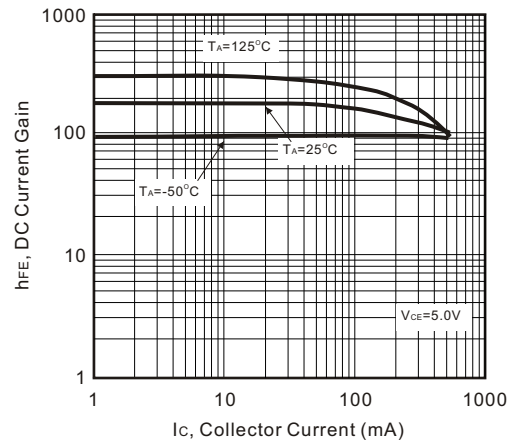


Fig. 3 Typical Capacitance

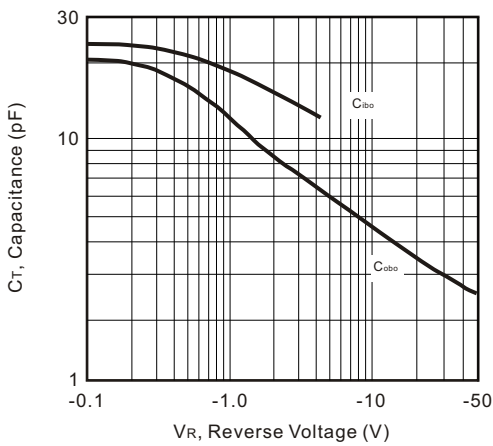


Fig. 4 Typical Collector Saturation Region

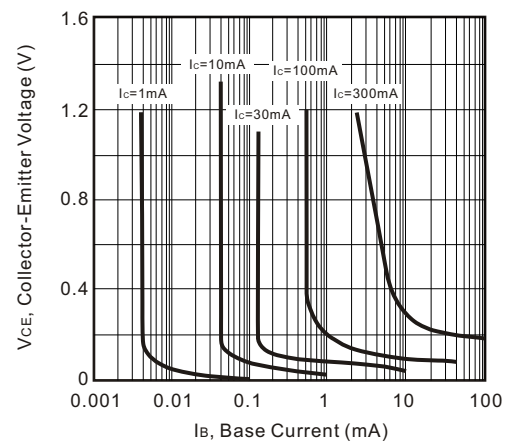


Fig. 5 Collector-Emmitter Saturation Voltage vs. Collector Current

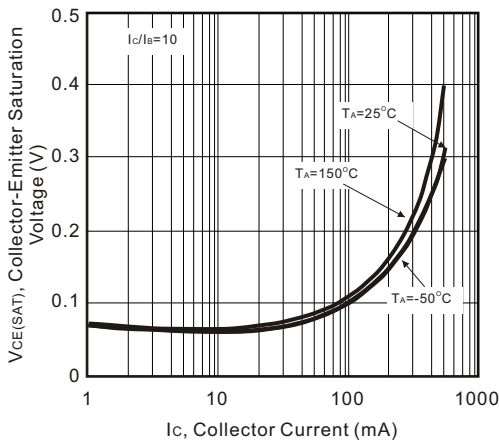
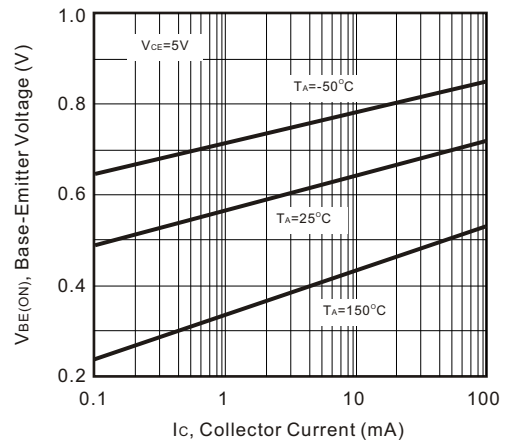


Fig. 6 Base-Emmitter Voltage vs. Collector Current





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.